

PN 结 Si 光电池

描述

工作在低频区域的 Si 光电池，可接收波长处于峰值波长附近的光信号。

应用

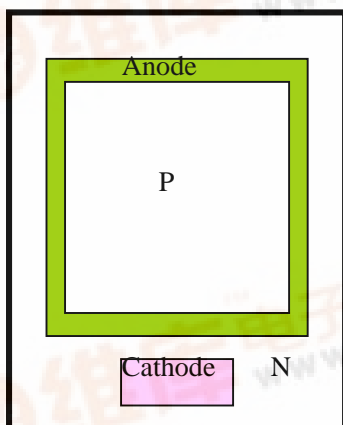
- 遥控电路
- 光纤通信

结构

芯片结构：平面 PN 型结构

电极：顶部 AlSi

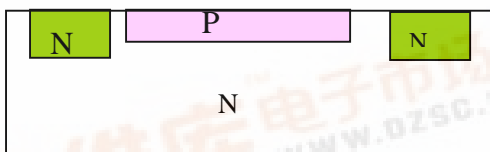
外形图和尺寸



芯片尺寸：12 mm × 8 mm

芯片厚度：300±25μm

纵向结构



芯片结构：平面 PN 型结构

电极：AlSi

光电特性 ($T_a=25^\circ$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
暗电流 Reverse dark current	I_D	$V_R=10V$ $E=0mW/cm^2$			30	nA
反向击穿电压 Reverse breakdown voltage	V_{BR}	$I_R=100\mu A$, $H=0mV/cm^2$			50	V